

2017 年 04 月 03 日

報道関係者 各位

会社名 レーザーテック株式会社
東証第1部コード6920
横浜市港北区新横浜2-10-1
代表者名 代表取締役社長 岡林 理
発表担当 経営企画室 室長 浅井 浩志

新製品 EUV マスクブランクス欠陥検査/レビュー装置
ABICS「E120」を発表

【概 要】

この度レーザーテックは、EUV マスクブランクス欠陥管理と歩留まりの向上に貢献する検査装置、EUV マスクブランクス欠陥検査/レビュー装置 ABICS「E120」を製品化いたしました。同装置は4月5日から開催されるホトマスクジャパンに出展いたします。

【内 容】

当社は、長年にわたりフォトマスク及びマスクブランクス検査の技術開発を行ってまいりました。そこで開発した高い感度を持つ検査装置はマスクブランクスの出荷検査やプロセス管理に活用され、高い評価と信頼を得ております。

一方、デバイスパターンの微細化に伴い、次世代露光技術である EUV リソグラフィの実用化の時期が迫っており、EUV マスクブランクス品質管理を行える検査装置の整備が急務となっています。

当社は2011年からの5年間、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による支援の下、株式会社 EUVL 基盤開発センター(EIDEC)^{※1}との共同研究を進め、EUV マスクブランクス欠陥検査装置(Actinic Blank Inspection(ABI)^{※2})の技術開発を手掛けてまいりました。

この度、当社は共同研究で開発した ABI 装置の技術を適用し、EUV 量産に対応した新たな EUV マスクブランクス欠陥検査/レビュー装置 ABICS「E120」を製品化いたします。

同装置は EUV 光を用いた検査/レビュー方式を採用しているため、転写性欠陥の選択的な検出と EUV 光による欠陥解析を行うことが可能です。これらの性能は EUV マスクブランクス欠陥管理や歩留まり向上に大きく貢献します。

※1 現社名 株式会社先端ナノプロセス基盤開発センター(コンソーシアム企業)
株式会社 EUVL 基盤開発センターは共同研究当時の社名

※2 EUVL に用いられる光源と同波長の光源を用いた装置

【特 長】

- Actinic inspection ($\lambda=13.5\text{nm}$ の EUV 光源を採用)
- Mo/Si 多層膜内部の転写性位相欠陥を高感度に検出
- 暗視野光学系による、高感度かつ高速な検査
- 高倍率のレビューによる高精度欠陥座標取得
- 明視野/暗視野レビューによる欠陥解析

【用 途】

- EUV マスクブランクス(Mo/Si 多層膜)の検査
- EUV マスクブランクス欠陥解析
- 欠陥の高精度位置検出



ABICS E120

◇お問い合わせ先◇

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1

レーザーテック株式会社 第1ソリューションセールス部 神山 弦一郎

TEL:045-478-7337 FAX:045-478-7333

E-mail: g_kamiyama@lasertec.co.jp